

誘起起電力 V

Φの時間的変化率
→ 磁束の変化率
→ 磁束の変化率
→ 磁束の変化率
Φの時間的変化率
→ 磁束の変化率
→ 磁束の変化率
Φの時間的変化率
→ 磁束の変化率
→ 磁束の変化率

$$V = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

$$V = -N \mu_0 \mu_r S \frac{di}{dt}$$

$$= -N \mu \frac{N_1 S}{l} \frac{di}{dt}$$

$$= -\frac{\mu N^2 S}{l} \frac{di}{dt}$$

$$\text{結局、} = -\mu n^2 l S \frac{di}{dt}$$

係数部分を L とおいて直せば、

$$V = -L \frac{di}{dt} \quad \dots (a)$$

この L を自己インダクタンスと呼ぶ!

単位は H (ヘンリー) を用いる。(人名)

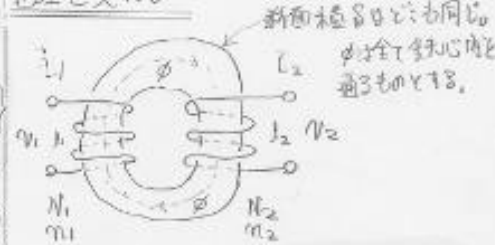
ちなみに P はワット (人名)

V は電圧の単位 V (ボルト) である

《以上は自己誘導》

以上の考察過程で考えた磁束 Φ の
流通を鉄芯作り、その 1 のコイル (N1) を
通り流し置いて見る。⇒ 右の図

電圧を変えろ



N2 に関係し、誘起起電力が起る。
電圧 V2 を求めると、

$$V_2 = -N_2 \frac{d\Phi}{dt} \quad (\Phi \text{ は } N_1, N_2 \text{ 共通})$$

また、Φ を求めると、

$$\Phi = BS = \mu n_1 l_1 i_1 S$$
$$= \mu \frac{N_1}{l} i_1 S \quad \dots (b)$$

式 (b) を式 (a) に代入すると、

$$V_1 = -N_1 \frac{d\Phi}{dt} \quad \dots (c)$$

式 (c) を式 (a) に代入すると、
式 (b) を式 (a) に代入すると、
式 (b) を式 (a) に代入すると、

$$V_2 = -N_2 \left(-\frac{V_1}{N_1} \right)$$

$$= \frac{N_2}{N_1} V_1$$

故に V2 は V1 の $\frac{N_2}{N_1}$ 倍の電圧となる。

$$\Rightarrow N_1 = 100, N_2 = 200 \text{ の場合}$$

$$V_2 = 2V_1 \quad \dots \text{2倍の電圧を得る。}$$

(d) × (e) の式から V2 が求まる。

これが変圧器の原理である。

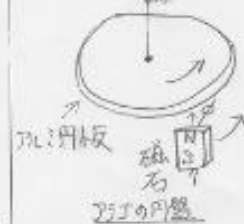
鉄芯の損失 電力的ロス

理想は存在しない

1. 電流が流れると磁場 (磁束 Φ) が
発生する。Φ の流れる鉄芯の様を
導体 (自由電子が次々詰まっている)
と置く。次々 Φ を小さくすると、
導体内には、Φ を小さくする様に向かう
電流 (IE) が流れる。



渦電流と呼ぶ
IE: Eddy Current



磁石を矢印方向に
動かすと、金属板の中
に磁石の動きを止める
向きに渦電流が
発生する。その結果、
金属板に渦電流が
発生し、磁石の動きを
止める。

これは導体内の電流の作用であるので複雑。

→ 渦電流損失と呼ぶ

アーク炉や電圧計
(家庭用電圧計)

→ ほぼ、ほぼ「電流の量」に比例する

2. 導体は、いかなる抵抗 (R) を
持つので、そこで電力が食われ
ば (消費)。PE = R Ie^2 [W]

Ie は導体内に無数に存在するので
それ相当の電力が消費される。

⇒ つまり、二流線が電力を取り取
なくとも一次側に電源を繋いで
付けて消費される。

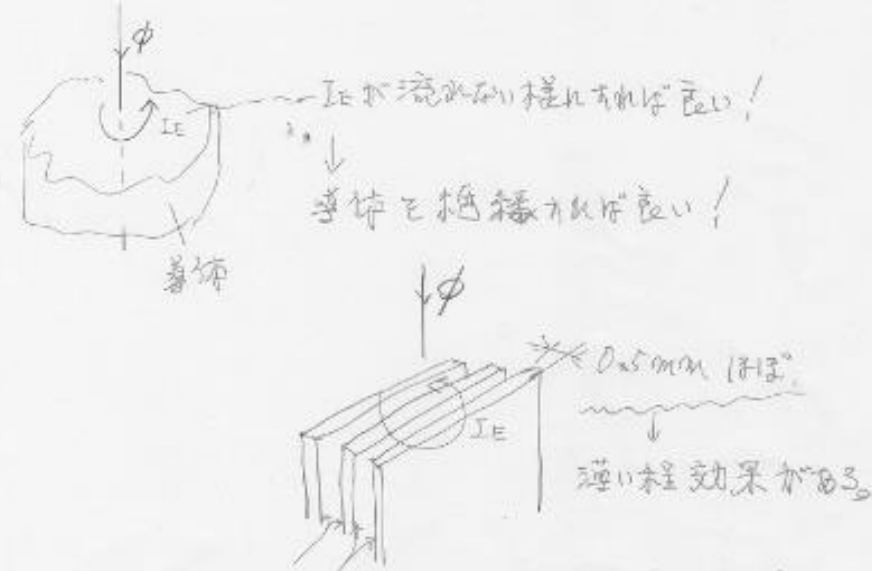
これは 待機電力と呼ぶが、
変圧器の世界では「無負荷損失」
と呼ぶ。

「ロス損失」と呼ぶ

これの理由により、少ない電圧、
電流で済ませよう。

500W クラスの変圧器では、損失
15W くらいだ!

渦電流損を小さくする



絶縁塗料を塗って密着しておく。
またトランスは木トを使う!
→ 曲げると I_e が大きくなり、
損失が大きくなる。(絶縁抵抗が減少する原因)
"0.05mm" と表示されているのは絶縁塗料の厚さ。

効率を考慮してトランスは製作されている。

渦電流損の積分的利用

送電線の電流を大きくし、損失を大きく(大きな発熱)なす様に製作すれば、電気がまよ、IHが出来る。損失は、電源周波数に比例するので、周波数を上げれば発熱も大きくなる。

磁束を測ると、空芯心内部の磁束が測れる。

v_2 を求めて見る

$$v_2 = -N_2 \frac{d\phi}{dt} \quad \dots (d)$$

→ 定電圧。ここで、
 v_2 と ϕ は時間 t とともに変化する。
これを表すと、 $\Rightarrow v_2(t), \phi(t)$
(d)式を書き直すと、

$$v_2(t) = -N_2 \frac{d\phi(t)}{dt} \quad \dots (e)$$

この式で、何と何 $\phi(t)$ が得られるのか?
試しに (e) 式の両辺を時間 t で積分してみる

$v_2(t)$ と $\phi(t)$ に微小時間 dt をかけて、足し算してゆくこと。記号は \int を用いる。
Sum: 総和の意味

$$\int v_2(t) dt = \int -N_2 \frac{d\phi(t)}{dt} dt$$

$$\int v_2(t) dt = -N_2 \phi(t)$$

$$\therefore \phi(t) = -\frac{1}{N_2} \int v_2(t) dt \quad \dots (f)$$

上の (f) 式より、二次電圧 $v_2(t)$ を何らかの方法で積分出来れば出来る。

交流波形を積分すると?

仮りに、 $v_2(t) = \sin(\omega t)$ とする。
ただし $\omega = 2\pi f$

t で積分すると、

$$\int v_2(t) dt = -\frac{1}{\omega} \cos(\omega t) \quad \dots (g)$$

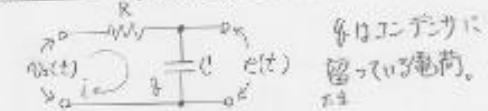
図で表すと、



積分の実理、方法

- (1) $v_2(t)$ を計算して求める。
- (2) 電子回路的にリアルタイムで求める。

(2) について → 解法は詳細は省略する



$$v_2(t) = RC \frac{de(t)}{dt} \quad \dots (h)$$

$$\int v_2(t) dt = RC e(t) \quad \dots (i)$$

$$e(t) = \frac{1}{RC} \int v_2(t) dt \quad \dots (j)$$

$$v_2(t) = RC \frac{de(t)}{dt} \quad \dots (k)$$

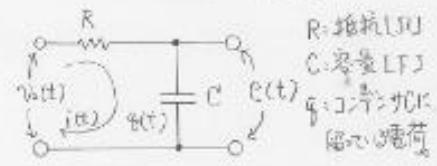
$$\int v_2(t) dt = RC e(t) \quad \dots (l)$$

$$\phi(t) = -\frac{RC}{N_2} e(t) \quad \dots (m)$$

$e(t)$ を測定する事によって、磁束 ϕ が測れる。

積分の実現方法

(2) 電子的クリリヤムで求める。
—RC積分回路の補足—



R: 抵抗 [Ω]
C: 容量 [F]
φ: コンデンサに蓄電した電荷

1. コンデンサCの端子間電圧 $v_2(t)$ は、
 $v_2(t) = C \frac{dq(t)}{dt}$ であり、
 $q(t) = \int i(t) dt$ である。
ここで $i(t) = \frac{v_1(t)}{R}$ である。

RC回路に流れ流 $i(t)$ として、
電圧式を立てて見る。
 $v_1(t) = R i(t) + v_2(t)$ (1)
ここで $v_1(t) \gg v_2(t)$ なる場合はRCを無視、
計算にこの意味。

$v_1(t) \approx R i(t)$ (2)
—これは近似の意味。
例えば $v_1(t) = 1000$, $v_2(t) = 1$ の時は、
 $1000 = R i(t) + 1$ となり、
 $999 = R i(t)$ となり $v_1(t)$ と $R i(t)$ は、
ほぼ等しいと言える。→ 1% の誤差。
電子回路計算ではよく使われる。

—1. 電流 $i(t)$ は単位時間に流れる電子の
電荷 q の移動量なので、以下と書ける。
 $i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$ (3)

3式を上式(2)に代入すると、
 $v_1(t) = R \frac{dq(t)}{dt}$ (4)

(3)式を両辺を時間で積分する。
$$\int v_1(t) dt = \int R \frac{dq(t)}{dt} dt$$

$$= R q(t)$$

(4)式より $q(t) = C v_2(t)$ なる、上式は以下と書ける。
$$\int v_1(t) dt = RC v_2(t) \dots (5), (6)$$

この式の左側部分、つまり $\int v_1(t) dt$ と式(3)の
 $\int i(t) dt$ の部分は全く同じである。従って
右の式を(3)の式に代入して、次式を得る。

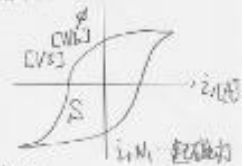
$$v_1(t) = -\frac{1}{N_2} \cdot RC \frac{dv_2(t)}{dt}$$

$$= -\frac{RC}{N_2} \frac{dv_2(t)}{dt} \dots (7), (8)$$

実際問題、抵抗RとC、および N_2 は
ほぼ、ほぼ固定である。従って、
RCの出力電圧、 $v_2(t)$ を測れば磁束φが測れる。
この時のRC回路は、RC積分回路と呼ばれる。
 $v_1(t) \gg v_2(t)$ である事から、
(電圧比で表現した関係式である。)

1. コンデンサ比で書くと換算する事が出来て、
 $R \gg \left| \frac{1}{j\omega C} \right| \rightarrow R \gg \frac{1}{\omega C}$ (ただし $\omega = 2\pi f$)
これより、RCの具体的な値を決められる。→ 50% 程度。
⇒ 理系大学の3年次レベル。

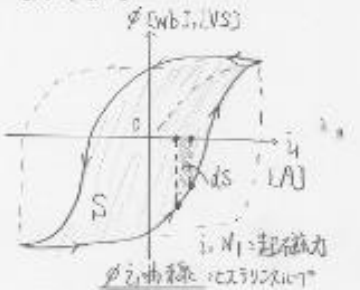
現実のトランスのφ(t)を測る、
一次側電流 $i_1(t)$ を横軸に
して作図すると、右図になる。
磁束φの次元はオルト・ウェーバ、
面積Sの次元はワット・秒 [W・s] であり、
(電流 × 時間) の次元はワット・秒 [W・s] となる。



① 現象入掌の石版複製
実験レポート作成に役立つ。

φ, φ曲線。

改めて書く。



この図は、極めて現実的な形です。

注) 1. 1. トランスの一次側に電源を付すと、
 i_1 による磁束φが発生させました。
そして、 N_1 匝巻いたのでφを発生させるための
磁束 ϕ は $N_1 i_1$ であり、起磁力と呼ぶので、
 $i_1 N_1$ とは無いので、

以上同様RC積分回路をトランスの二次側に
つなぐ時は、二次側には磁束検出用として
用いています。また、RC積分回路の位相遅延を
大くすれば、 i_2 はほぼ、ほぼゼロと近似出来る。
二次側をほぼ開放状態(ほぼ無負荷)と
出来る。従って、鉄心内のφを、ほぼ測定出来る
訳です。

面積Sについて
積分式で表わせば、
 $S = N_1 \int i_1 dt$ (9)

面積Sは磁束φの次元と一致する。磁束φの次元は
オルト・ウェーバ [Wb] であり、
面積Sの次元はワット・秒 [W・s] であり、
電流 × 時間 [A・s] の次元はワット・秒 [W・s] となる。

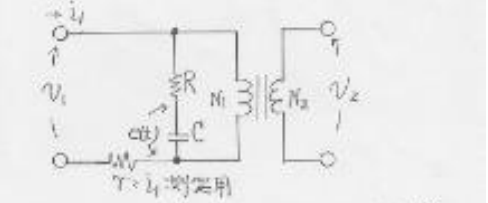
この電流の周波数 f を掛ければ、電力 P
が求まります。

$$P = f S \quad [W] \dots (10)$$

φ曲線は、ヒステリシスループ(履歴現象)。
往復繰り返る軌跡を描くとも呼ぶ。
これは、1秒間に f 回だけ、左回転します。
環、 S は電力に比例するので、二次側に
負荷を付すと、 i_2 は横方向になります。

RC積分回路の配置

N_1 匝巻いた自己誘導の原理より、一次側の電圧は
電源の電圧は自己誘導によって発生した電圧と
等価と見なせるので、RC積分回路を一次側に
置いても、磁束φが測れるはず。



v_1 は測定用であり、二次側回路に影響を
与えない程度の微小抵抗とします。
この時の磁束φは、 $\phi(t) = -\frac{RC}{N_1} \frac{dv_2(t)}{dt}$ となります。

以上の考察から、見直しはして、何の軌跡も無い場合
中では、別々の「電磁現象」が起きている事が
仮定は正しい。